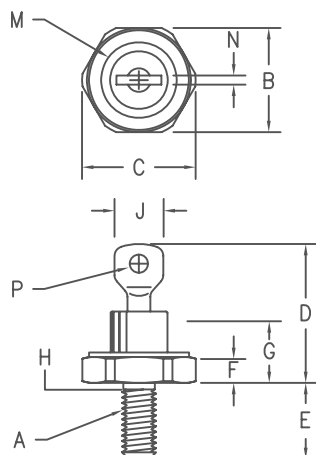


Silicon Power Rectifier S/R21 Series



Notes:

1. 10-32 UNF3A
2. Full threads within 2 1/2 threads
3. Standard Polarity: Stud is Cathode
Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	---	---	---	---	1
B	.424	.437	10.77	11.10	
C	---	.505	---	12.82	
D	.600	.800	15.24	20.32	
E	.422	.453	10.72	11.50	
F	.075	.175	1.91	4.44	
G	---	.405	---	10.29	
H	.163	.189	4.15	4.80	2
J	---	.310	---	7.87	
M	---	.350	---	8.89	Dia
N	.020	.065	.510	1.65	
P	.070	.100	1.78	2.54	Dia

D0203AA (D04)

Microsemi Catalog Number	JEDEC Numbers	Peak Reverse Voltage
1N2246,A	1N2598	50V
1N2248,A		100V
		150V
*S2120	1N2250,A	200V
	1N2252,A	300V
*S2140	1N2254,A	400V
	1N2256,A	500V
*S2160	1N2258,A	600V
		700V
*S2180	1N2260,A	800V
	1N3670,A	900V
	1N3671,A	1000V
*S21100	1N2262,A	1200V
*S21120	1N2264,A	1400V
*S21140		1600V
*S21160	1N5331	

*Change S to R in part number for Reverse Polarity
For 1N types, use an R suffix for Reverse Polarity

- Glass Passivated Die
- Low Forward Voltage
- 250A Surge Rating
- Glass to metal seal construction
- V_{RRM} to 1600V
- Low cost Non-RoHS package

Electrical Characteristics

Average forward current	IF(AV) 22 Amps	$T_C = 134^{\circ}\text{C}$, half sine wave, $R_{\theta JC} = 2.5^{\circ}\text{C/W}$
Maximum surge current	IFSM 250 Amps	8.3ms, half sine, $T_J = 200^{\circ}\text{C}$
Max I^2t for fusing	I^2t 260 A^2s	
Max peak forward voltage	V_{FM} 1.2 Volts	$I_{FM} = 30\text{A}; T_J = 25^{\circ}\text{C}$
Max peak reverse current	IRM 10 μA	$V_{RRM}, T_J = 25^{\circ}\text{C}$
Max peak reverse current	IRM 1.0 mA	$V_{RRM}, T_J = 150^{\circ}\text{C}$
Max Recommended Operating Frequency	10kHz	

*Pulse test: Pulse width 300 μsec . Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temperature range	T_{STG}	-65°C to 200°C
Operating junction temp range	T_J	-65°C to 200°C
Maximum thermal resistance	$R_{\theta JC}$	2.5°C/W Junction to Case
Mounting torque		25-30 inch pounds
Weight		.16 ounces (5.0 grams) typical

S/R21

Figure 1
Maximum Forward Characteristics

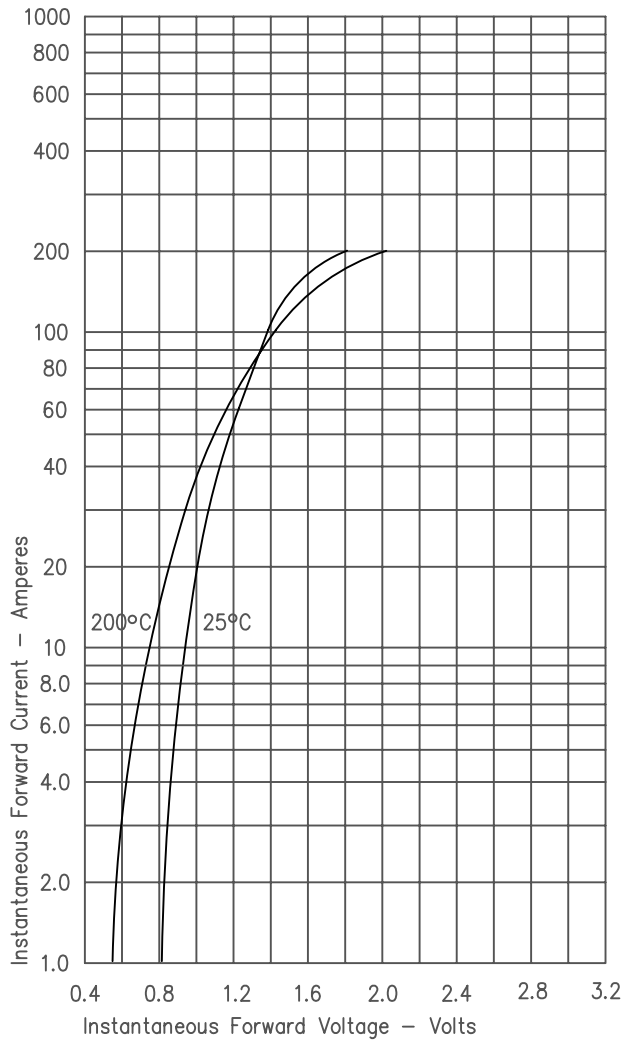


Figure 2
Typical Reverse Characteristics

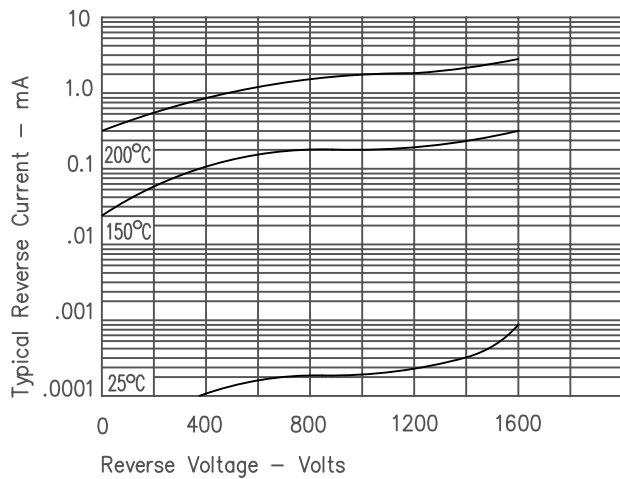


Figure 3
Forward Current Derating

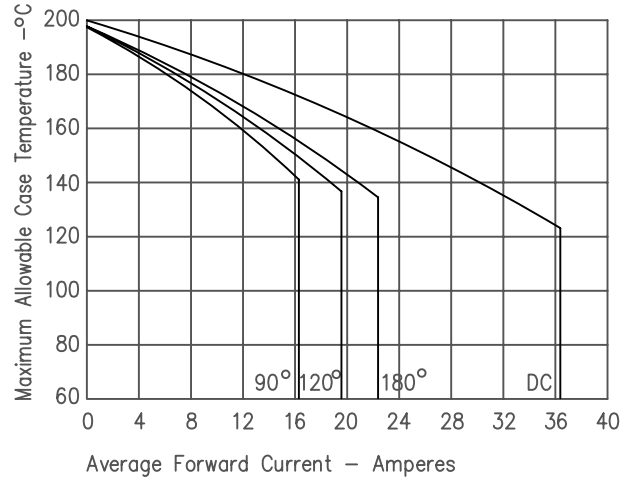


Figure 4
Maximum Forward Power Dissipation

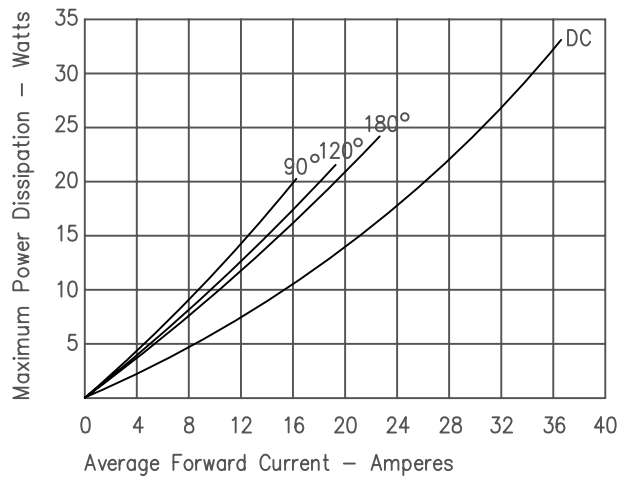
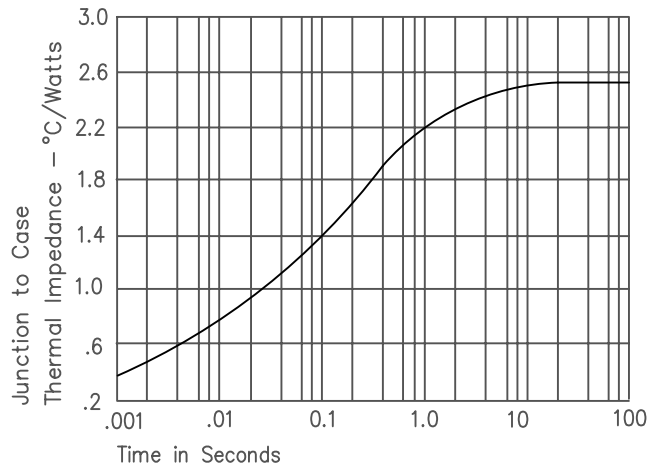


Figure 5
Transient Thermal Impedance



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9